2-1-6　考察

本調査の解析結果の概略は、Azzouz 地区(MJTK-IP04-1)で低比抵抗・高充電率の IP 異常帯を補足できたが、Hbibi 地区（MJTK-IP04-2)、Harch 地区（MJTK-IP04-3)、Maouch 地区(MJTK-IP04-4)、Khefawna 地区（MJTK-IP0-5）および Talzelt 地区(MJTK-IP-06)では IP 異常がみられなかった。

1)　空中磁気・地上磁気

IP 測線の設定は、IP 調査前に BRPM が Azzouz 地区、Khefawna 地区および Talzelt 地区で行った詳細な地上磁気測定結果を基に計画した。その他の地区は、空中磁気探査結果（第 1 年次調査）を基に計画した。

空中磁気および地上磁気測定結果は、Hbibi 地区、Harch 地区、Maouch 地区、Khefawna 地区および Talzelt 地区で比較的単調な磁気変化であるのに対し、Azzouz 地区では複雑な磁気変化を示している。

Azzouz 地区では、大きな磁気変化が見られる北部および東部で構造線が推定されている。

2)　比抵抗

調査地区全体に分布する新期堆積物の比抵抗は、約 50Ω・m 以下と考えられる。新期堆積物の分布状況は、比抵抗構造解析から概ね水平成層構造的を示す考えられ、Hbibi 地区、Harch 地区、Maouch 地区、Khefawna 地区および Talzelt 地区で層厚約 150m 以上、Azzouz 地区では調査域の東側程厚く堆積すると推定される。

Azzouz 地区の他の低比抵抗構造（約 50Ω・m 以下）は、調査地区北端(I,j,k 測線)、g(No.7)、h(No.10)、i(No.13)、j(No.16)および k(No.16)測線付近に解析された。調査地区北端の低比抵抗構造は、構造線位置に対応すると考えられ比較的深部まで延びると推定される。

g(No.7)、h(No.10)、i(No.13)、j(No.16)および k(No.16)測線付近の低比抵抗構造は、板状のものと推定され、NE-SW 系の方向で、ほぼ垂直を保ち深部まで延びると推定される。

3)　充電率

解析された充電率は、Hbibi 地区、Harch 地区、Maouch 地区、Khefawna 地区および Talzelt 地区が最大 20mV/V で異常は無い。Azzouz 地区は、最大 78mV/V である。

Azzouz 地区の比較的高い充電率構造は、深度約 50m で j,k 測線 No.14 付近、深度約 80m で d～r 測線に NE-SW 系の方向が明瞭である。深度約 110m 以深では、全体に深部ほど高い充電率構造を示す傾向にあるが、複雑な構造線により分離されるようである。

4)　メタルファクター

深度約 110m 以深の低比抵抗・高充電率域を抽出すると、g(No.7)、h(No.10)、i(No.13)、j(No.16)、k(No.16 付近)測線付近を最大に NE-SW 系の構造がみられる。

メタルファクターは、k 測線 No.15,16 付近が最大 1,222 である。
低比抵抗・高充電率域は、NE-SW 系の地上磁気異常帯の一部と調和する。
IP 調査のまとめとして地上磁気および IP 異常域を Fig.II-2-1-78 に示す。

本地区周辺の既存鉱山の鉱体は、磁硫鉄鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱、硫砒鉄鉱等を伴うため、高磁気および低比抵抗・高充電率の両面を考慮する必要がある。本調査結果で強い鉱化が期待されるのは、Azzouz 地区の g(No.7),h(No.10),i(No.13),j(No.16),k(No.16 付近)測線付近である。
IP 異常体は、板状と推定され深度約 110m 付近から深部に掛け、ほぼ垂直を保ち NE-SW 方向に存在すると考えられる。

本調査結果では、磁気異常帯と IP 異常帯に調和が見られる領域が抽出されるため石墨が IP 異常に関係しているとは考えがたいが、周辺の地質状況から石墨の存在を払拭できない。石墨の薄層を伴う地質が存在する場合は、鉱化帯と同様の IP 異常を示すと考えられる。
いずれにせよ IP 異常域でボーリング調査を行い異常帯の地質状況を確認する必要がある。

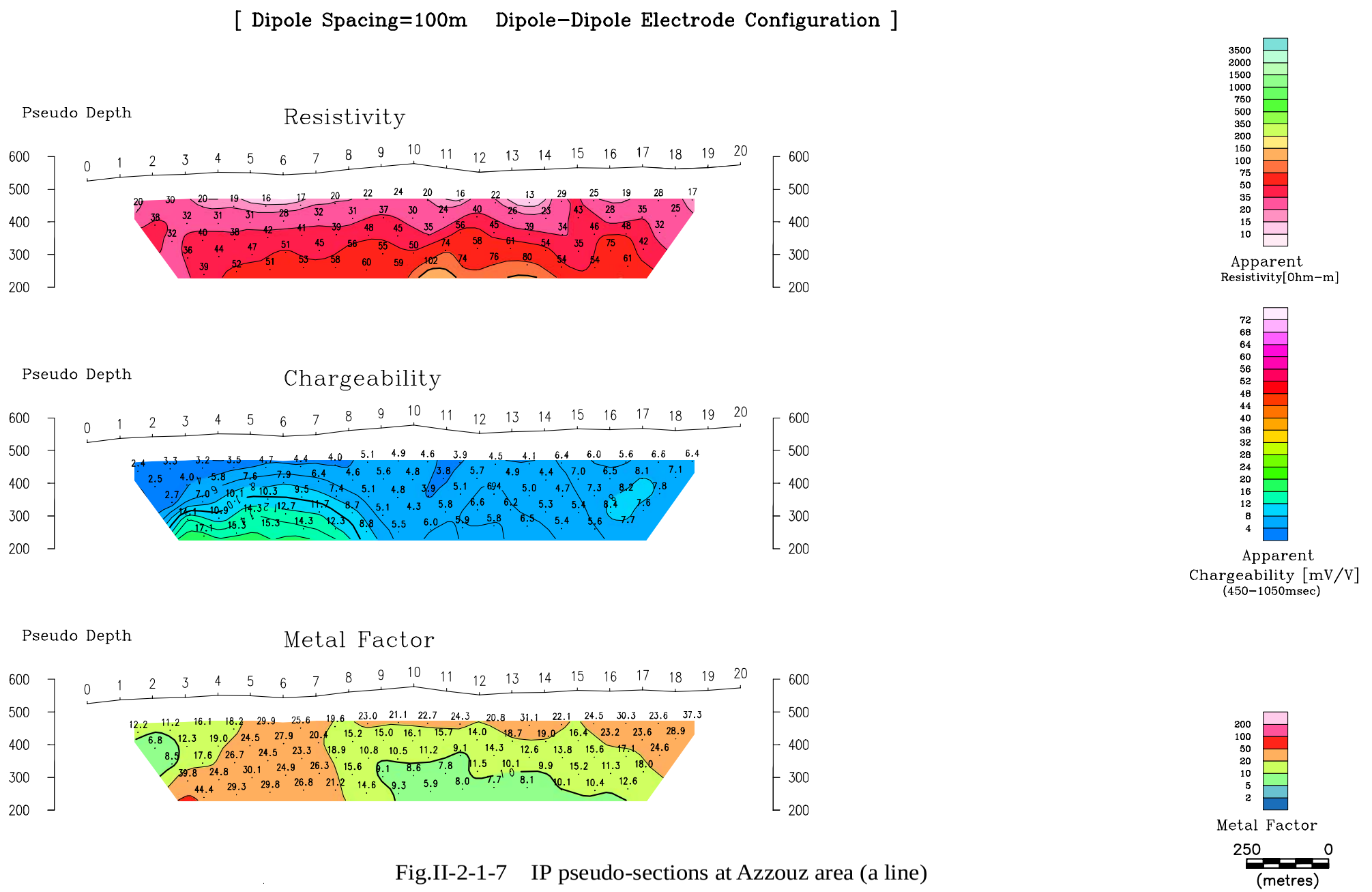


Fig.II-2-1-7 IP pseudo-sections at Azzouz area (a line)

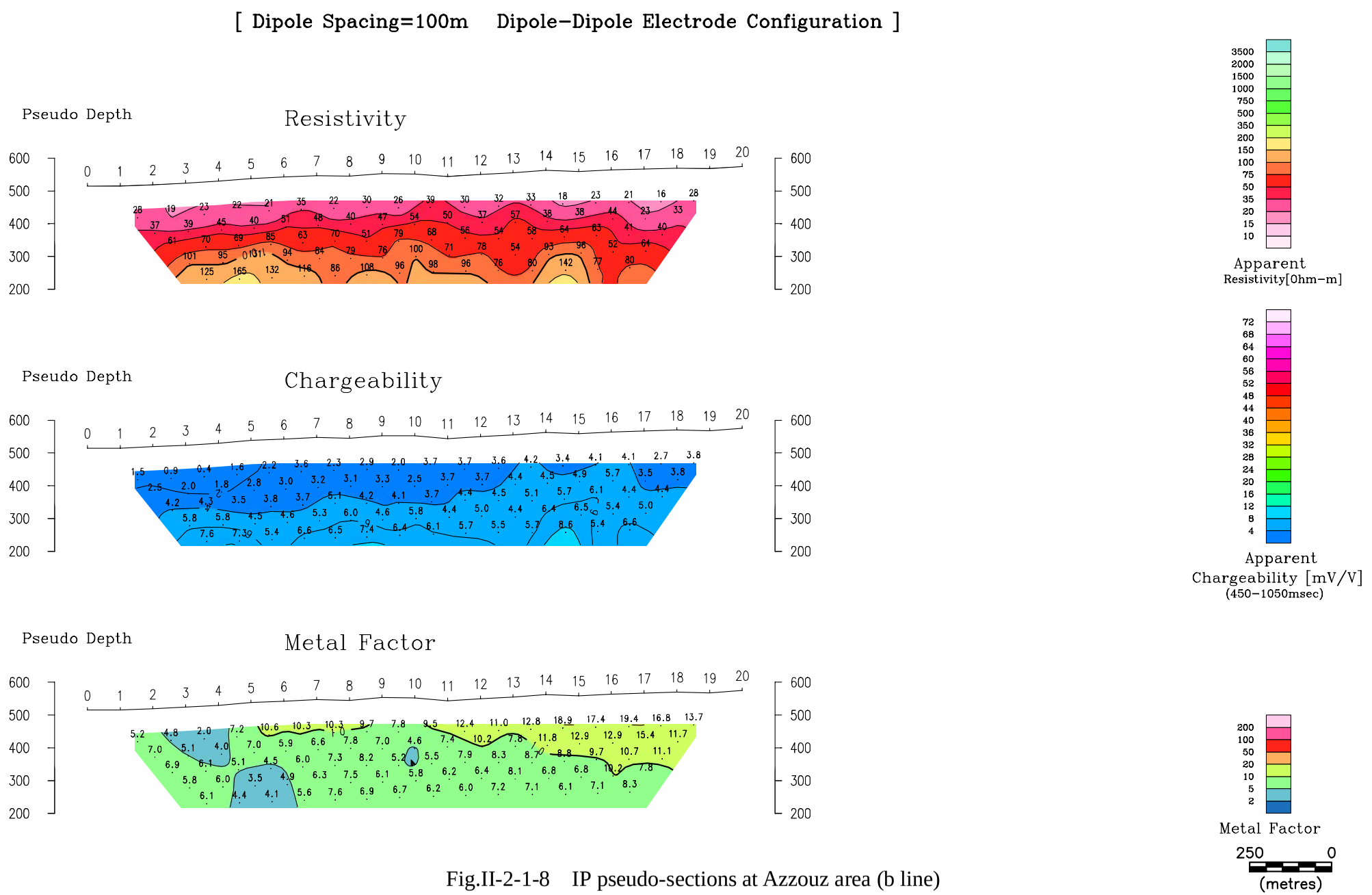


Fig.II-2-1-8 IP pseudo-sections at Azzouz area (b line)

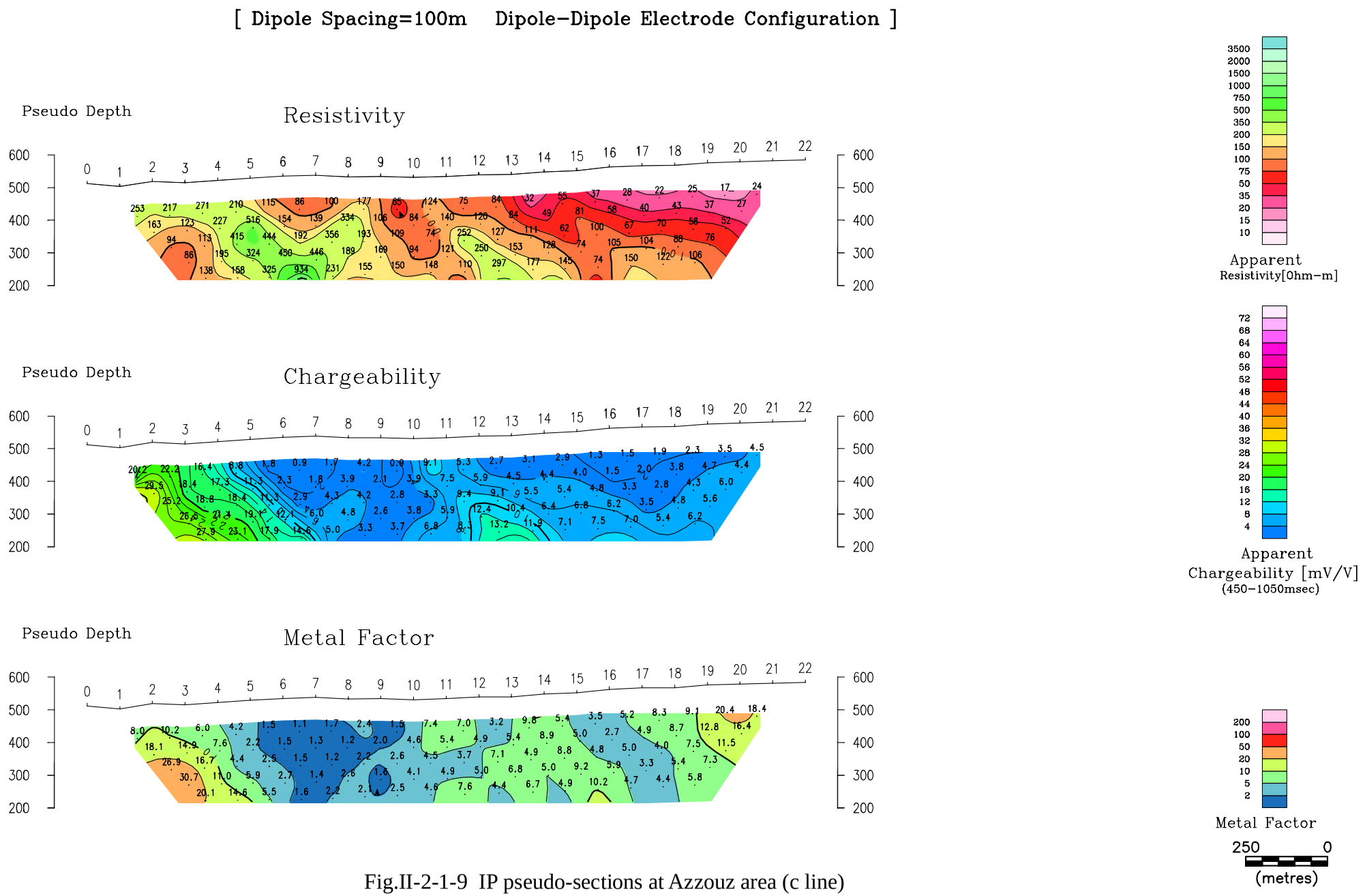


Fig.II-2-1-9 IP pseudo-sections at Azzouz area (c line)

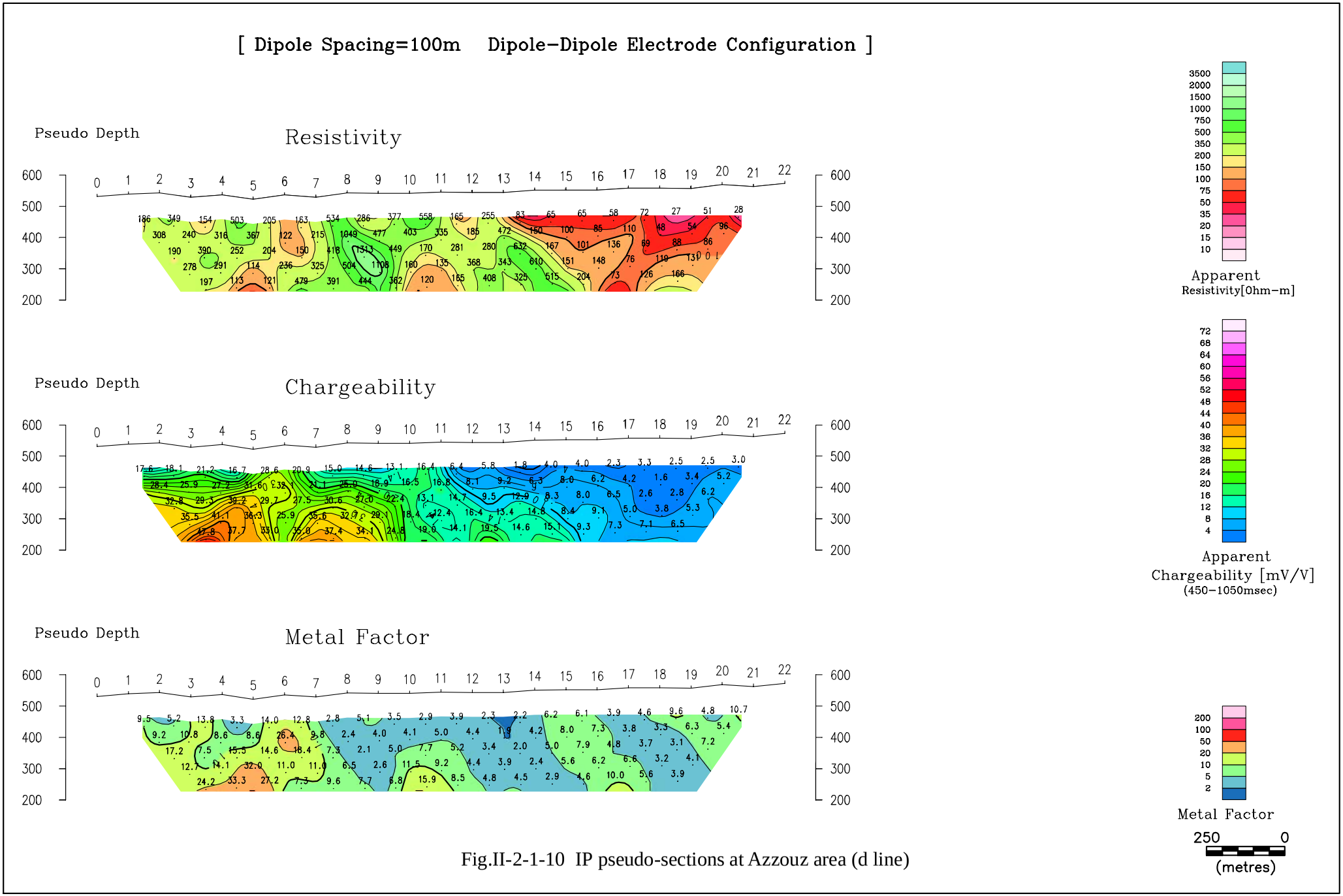


Fig.II-2-1-10 IP pseudo-sections at Azzouz area (d line)

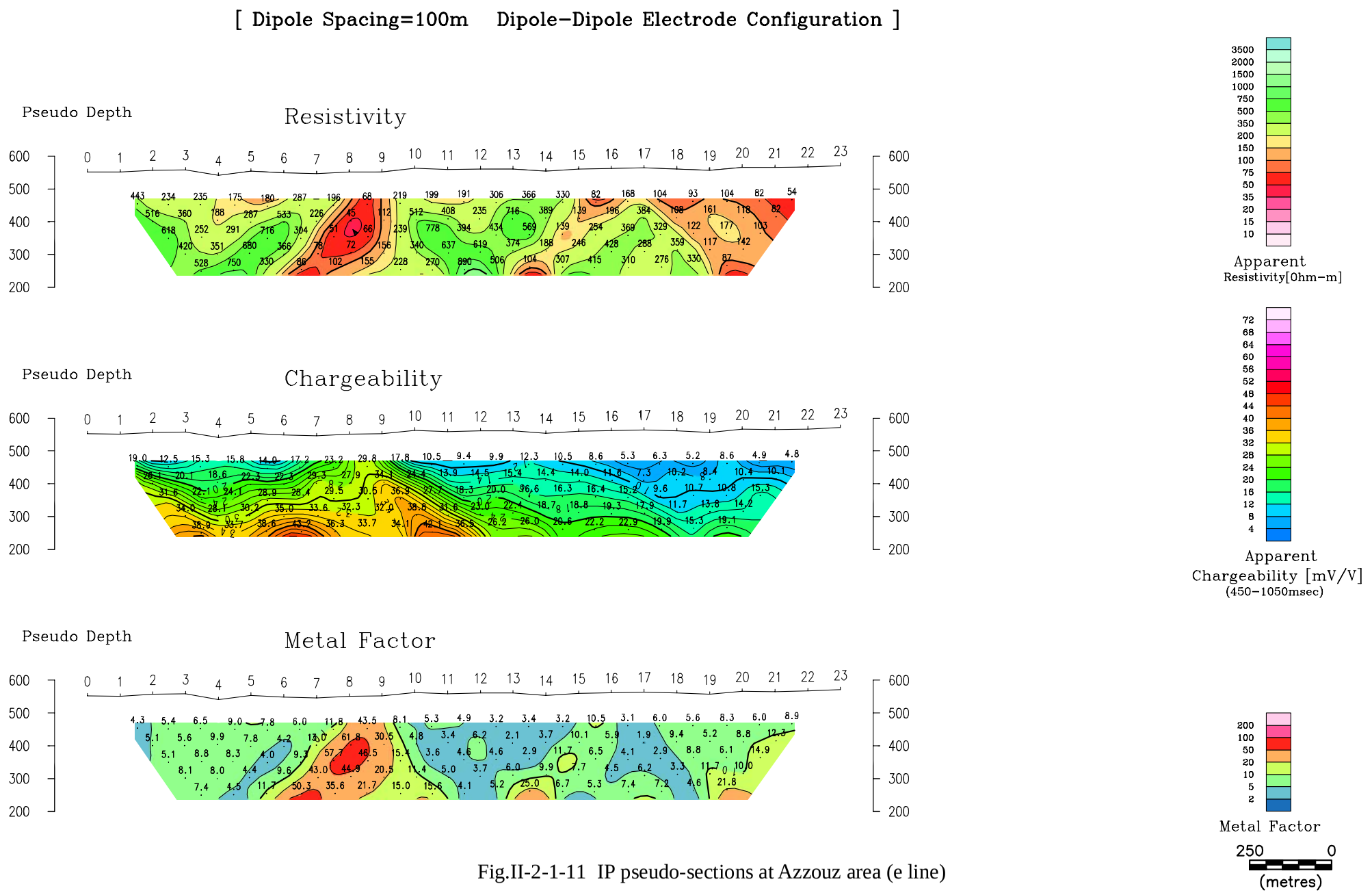


Fig.II-2-1-11 IP pseudo-sections at Azzouz area (e line)

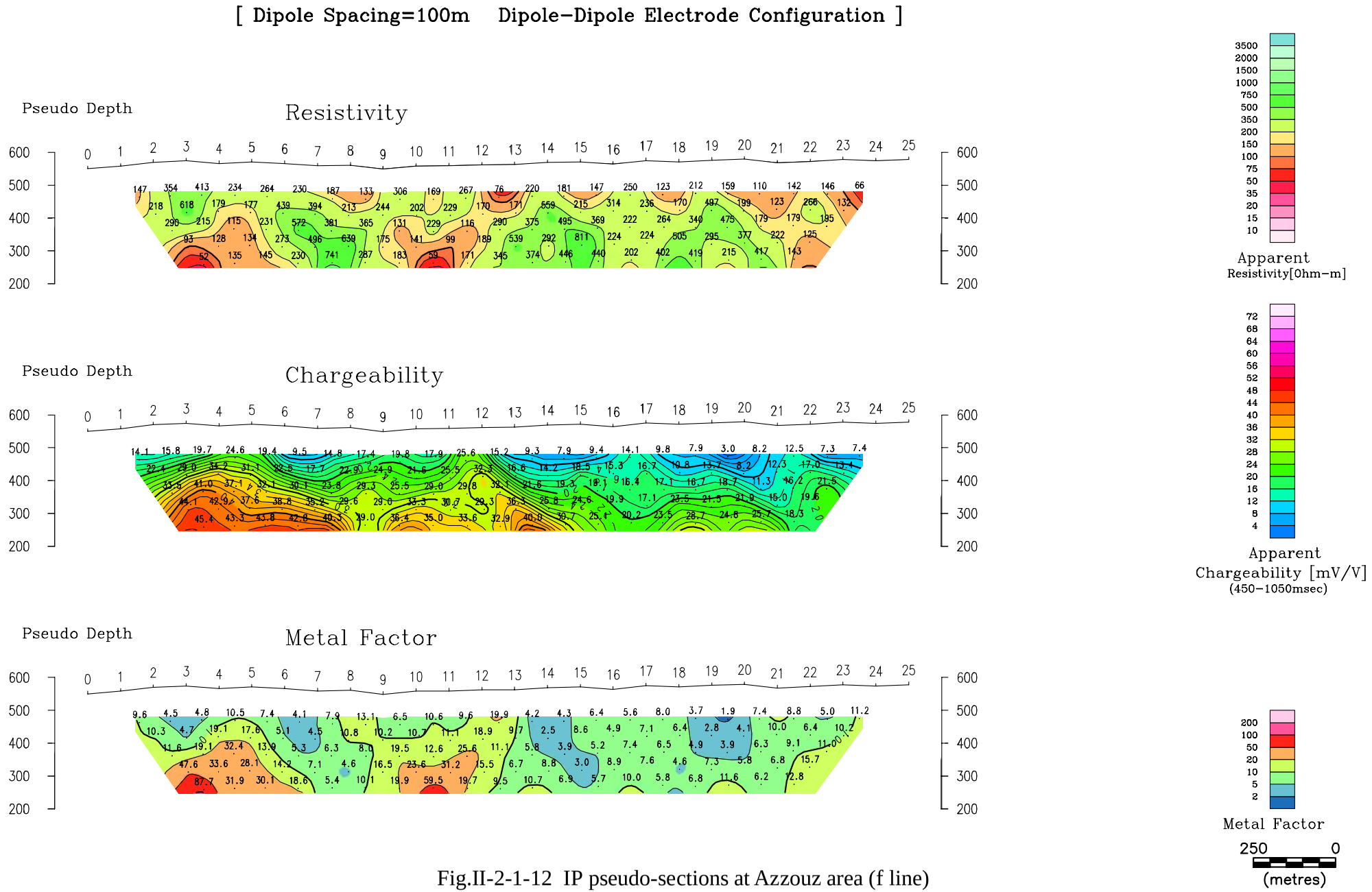
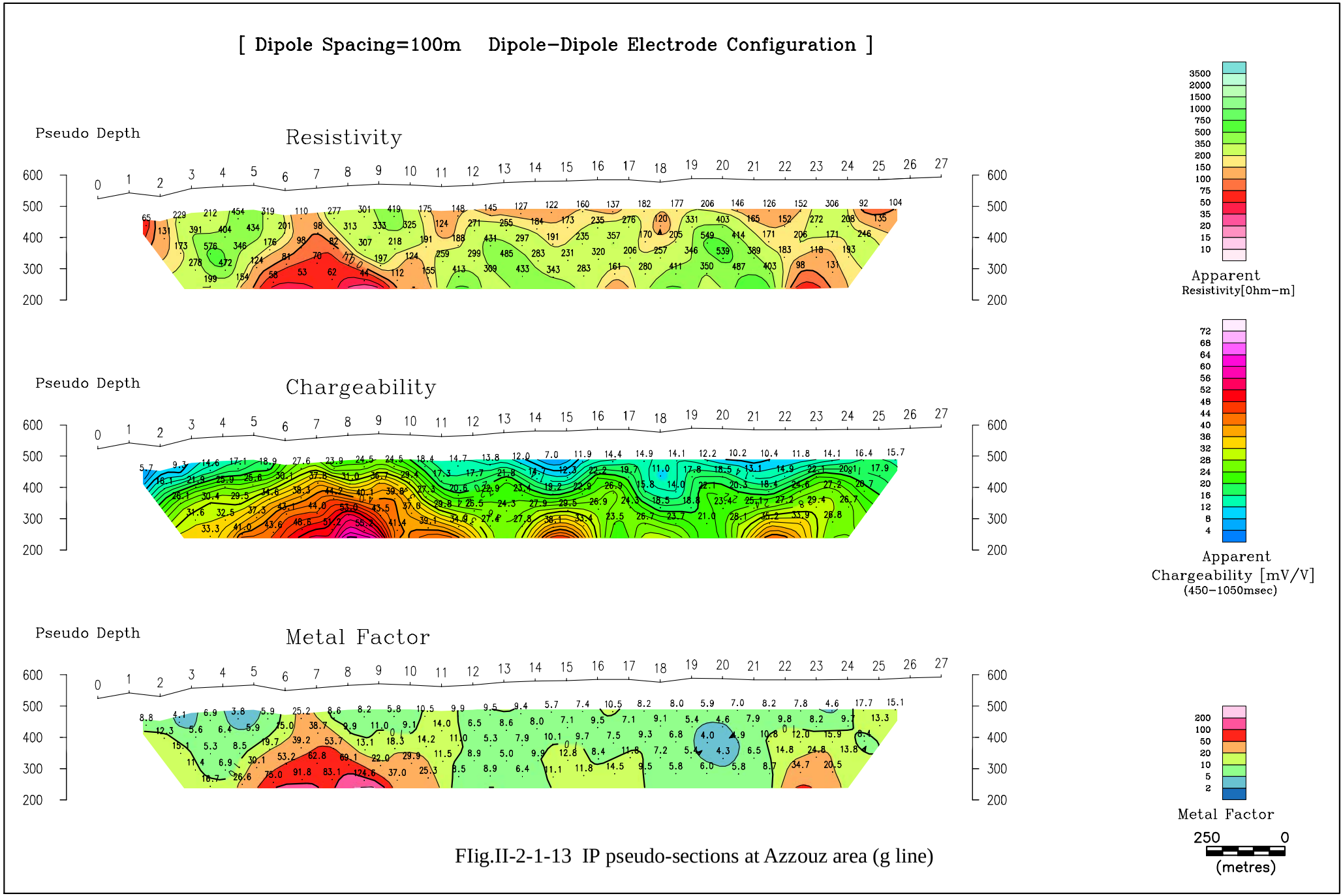


Fig.II-2-1-12 IP pseudo-sections at Azzouz area (f line)



FIig.II-2-1-13 IP pseudo-sections at Azzouz area (g line)

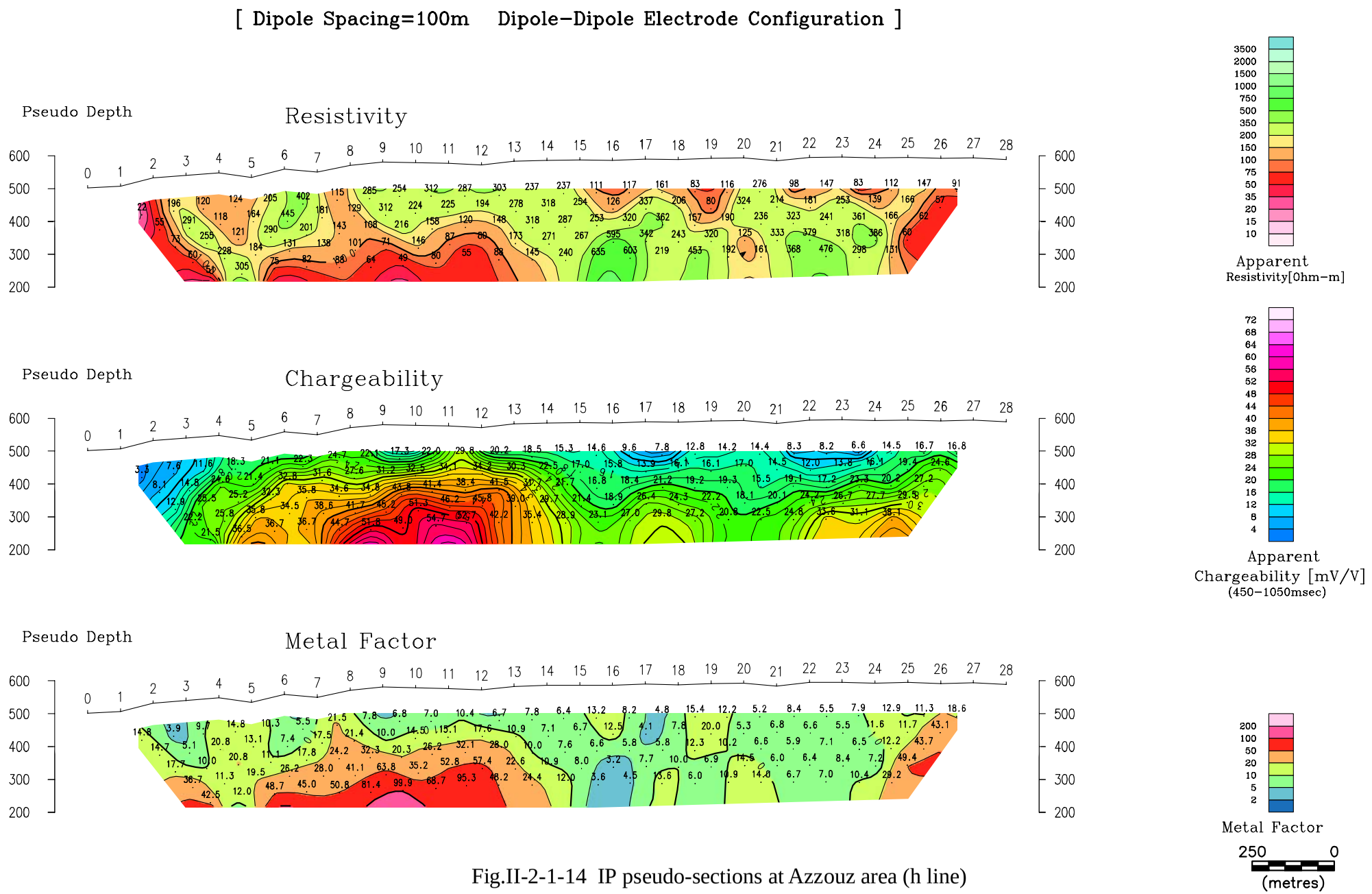


Fig.II-2-1-14 IP pseudo-sections at Azzouz area (h line)

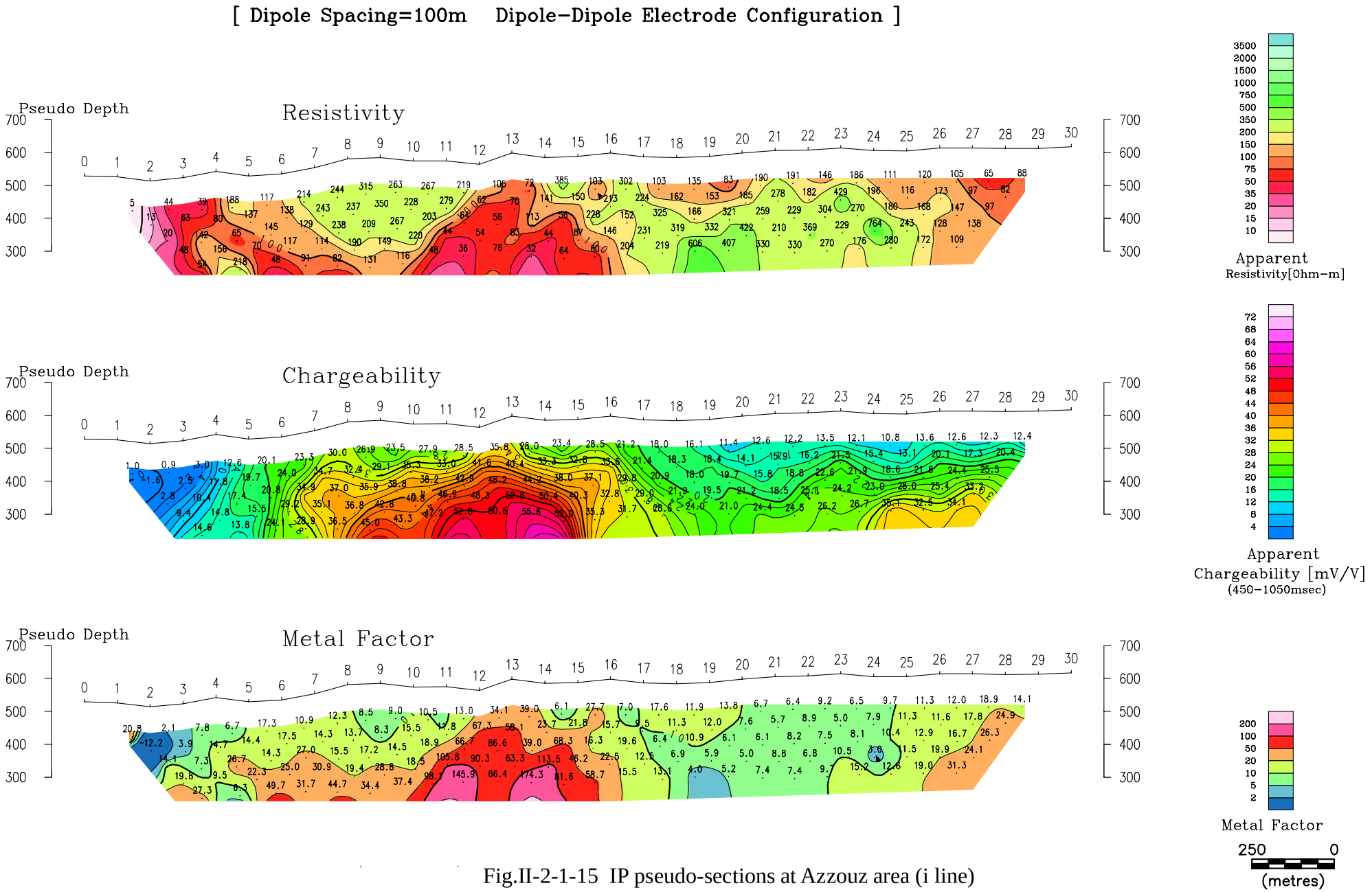


Fig.II-2-1-15 IP pseudo-sections at Azzouz area (i line)

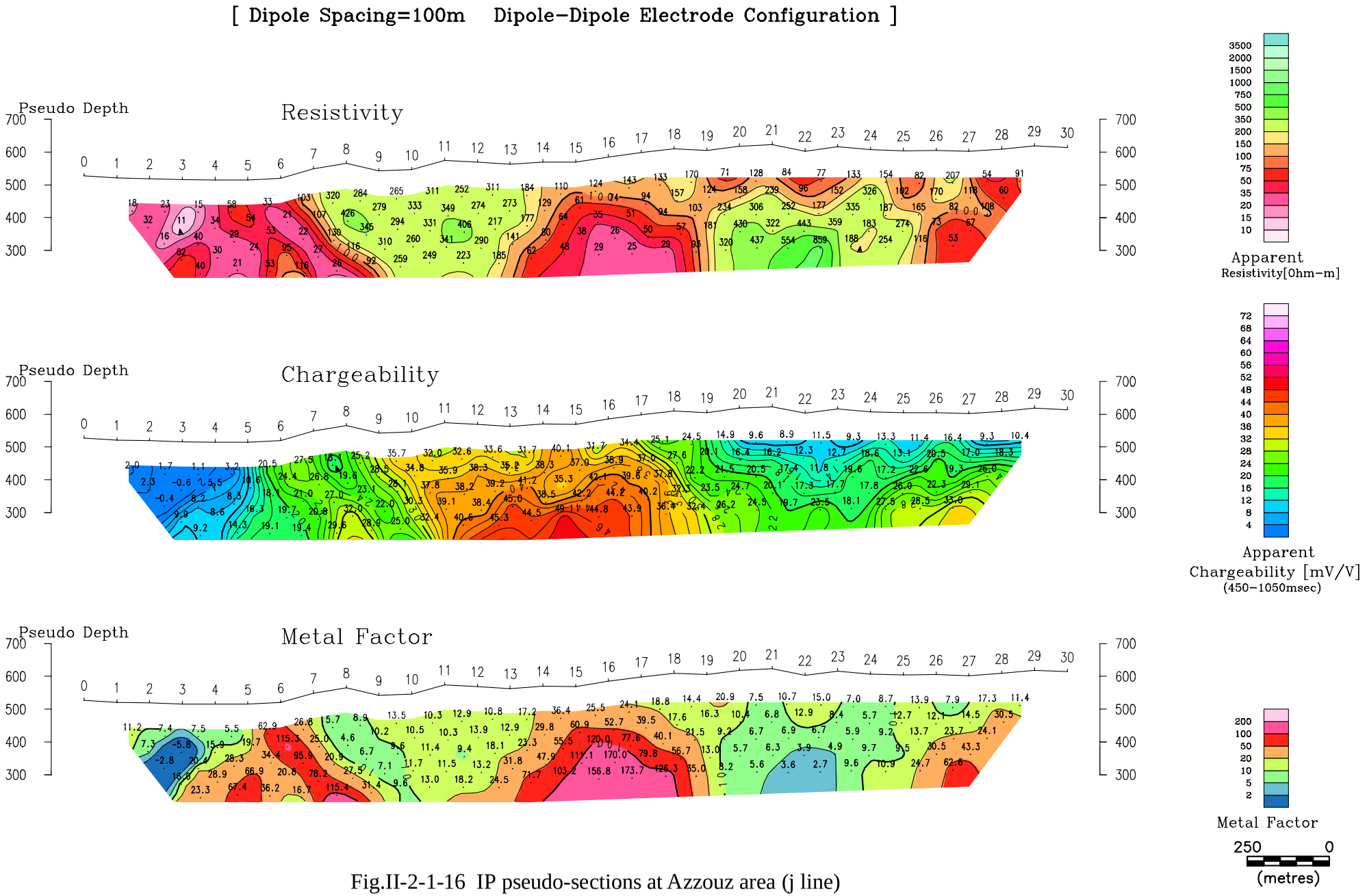


Fig.II-2-1-16 IP pseudo-sections at Azzouz area (j line)

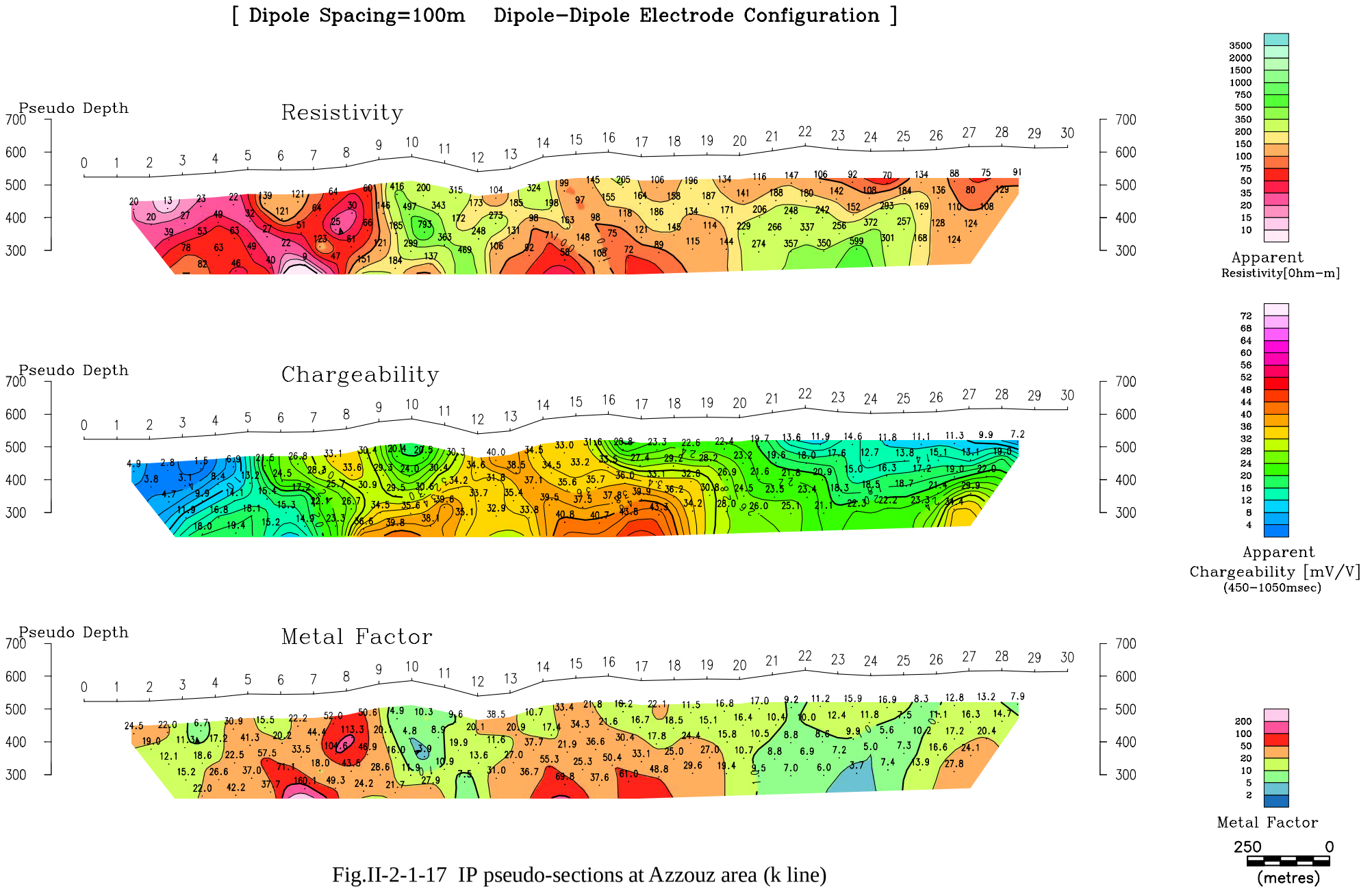


Fig.II-2-1-17 IP pseudo-sections at Azzouz area (k line)

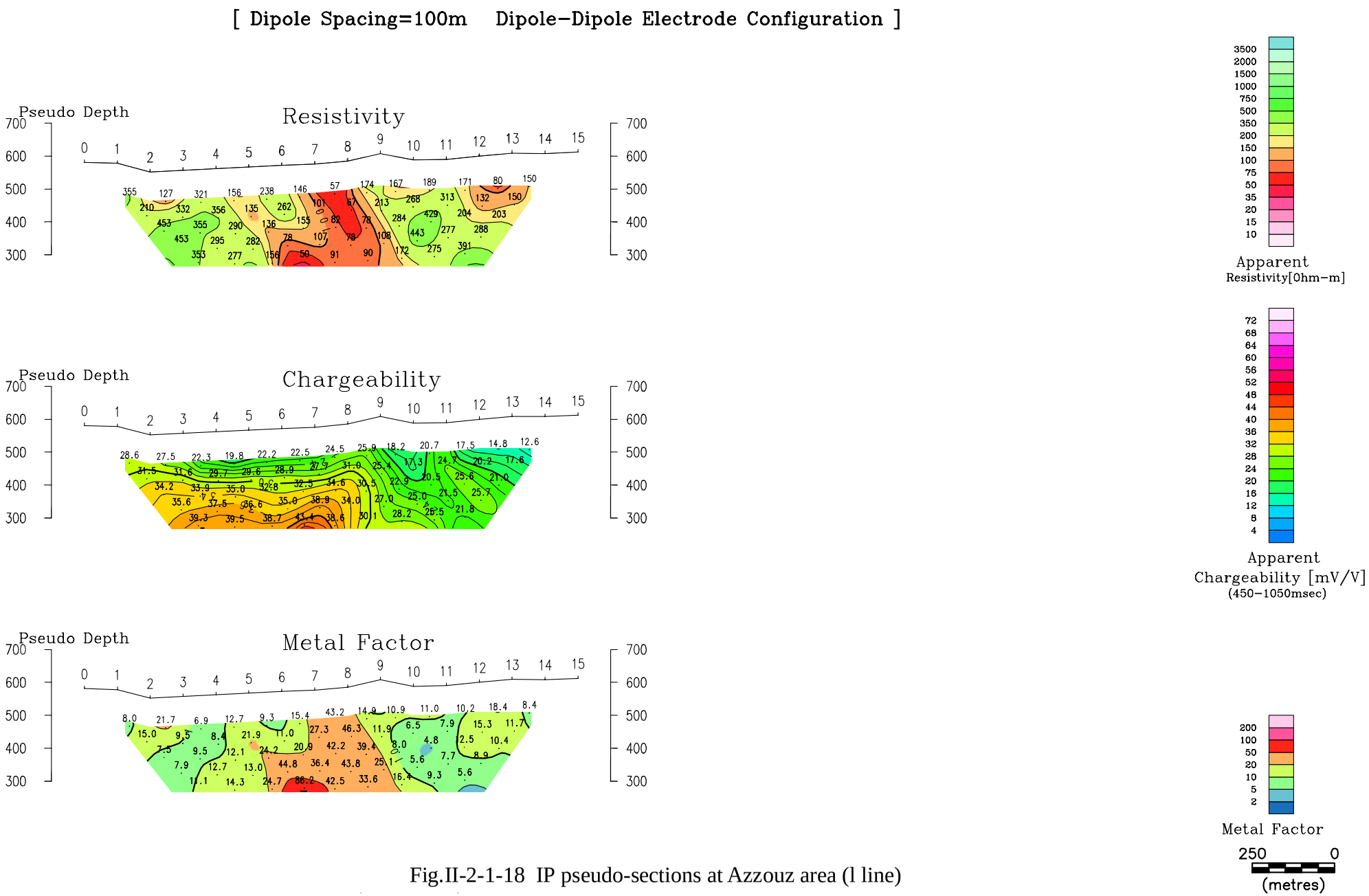


Fig.II-2-1-18 IP pseudo-sections at Azzouz area (l line)

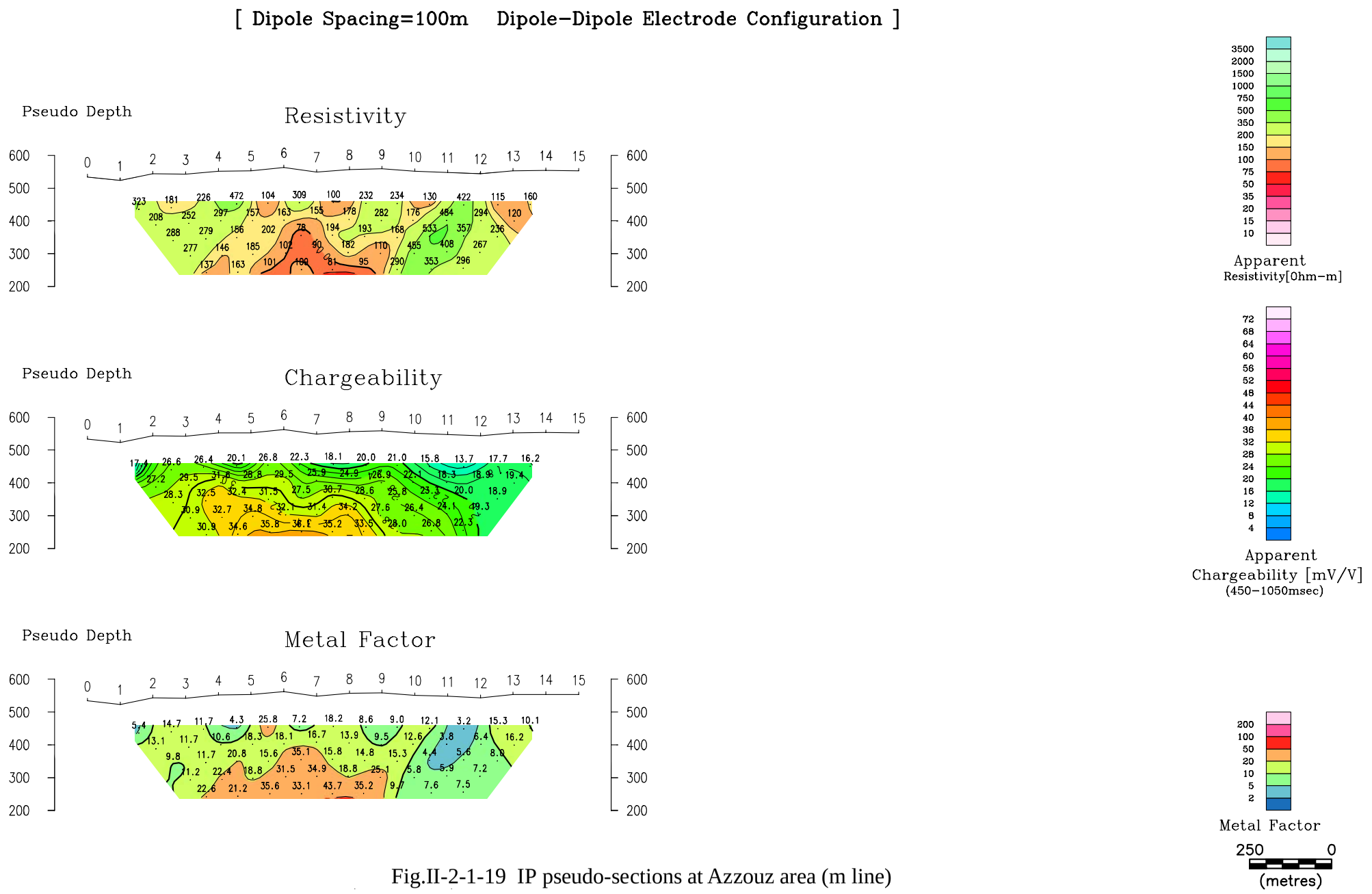
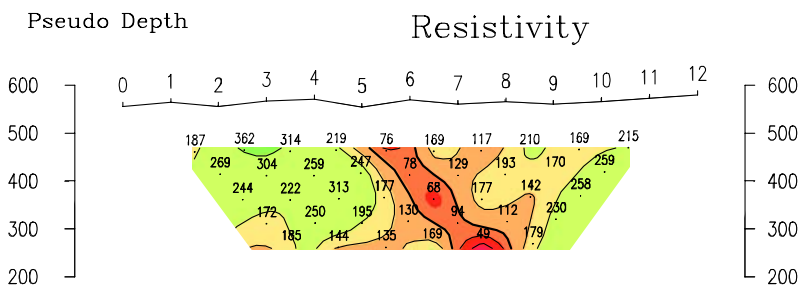
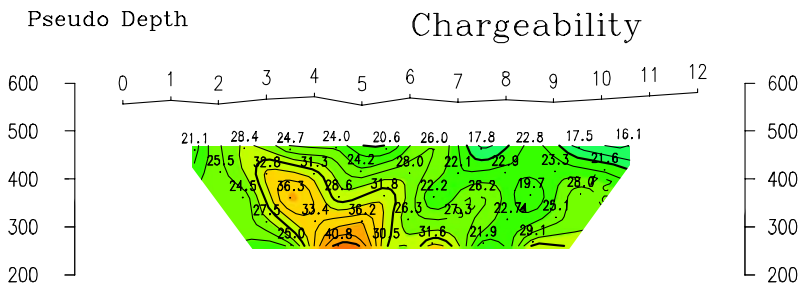
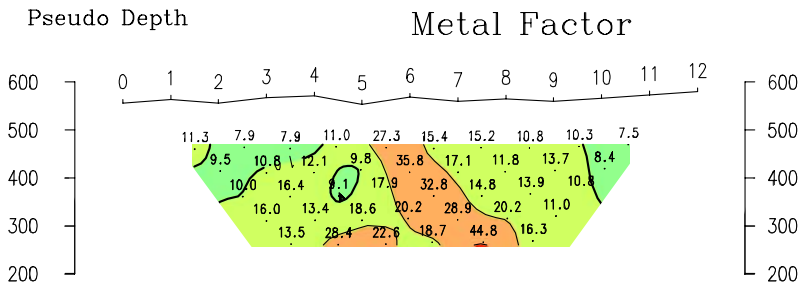


Fig.II-2-1-19 IP pseudo-sections at Azzouz area (m line)

[Dipole Spacing=100m Dipole-Dipole Electrode Configuration]







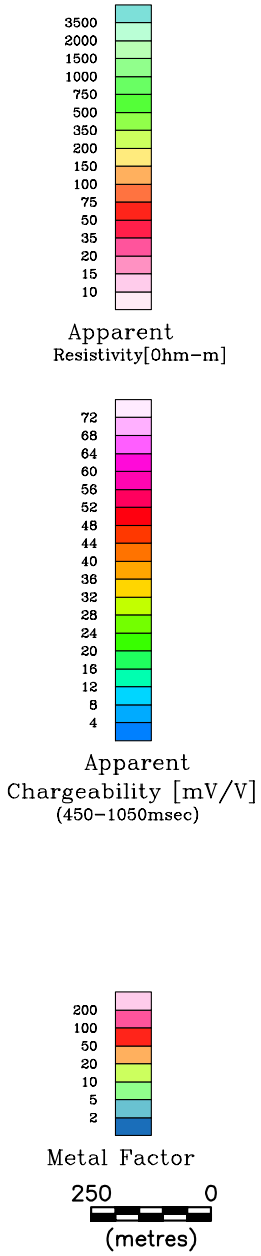


Fig.II-2-1-20 IP pseudo-sections at Azzouz area (n line)

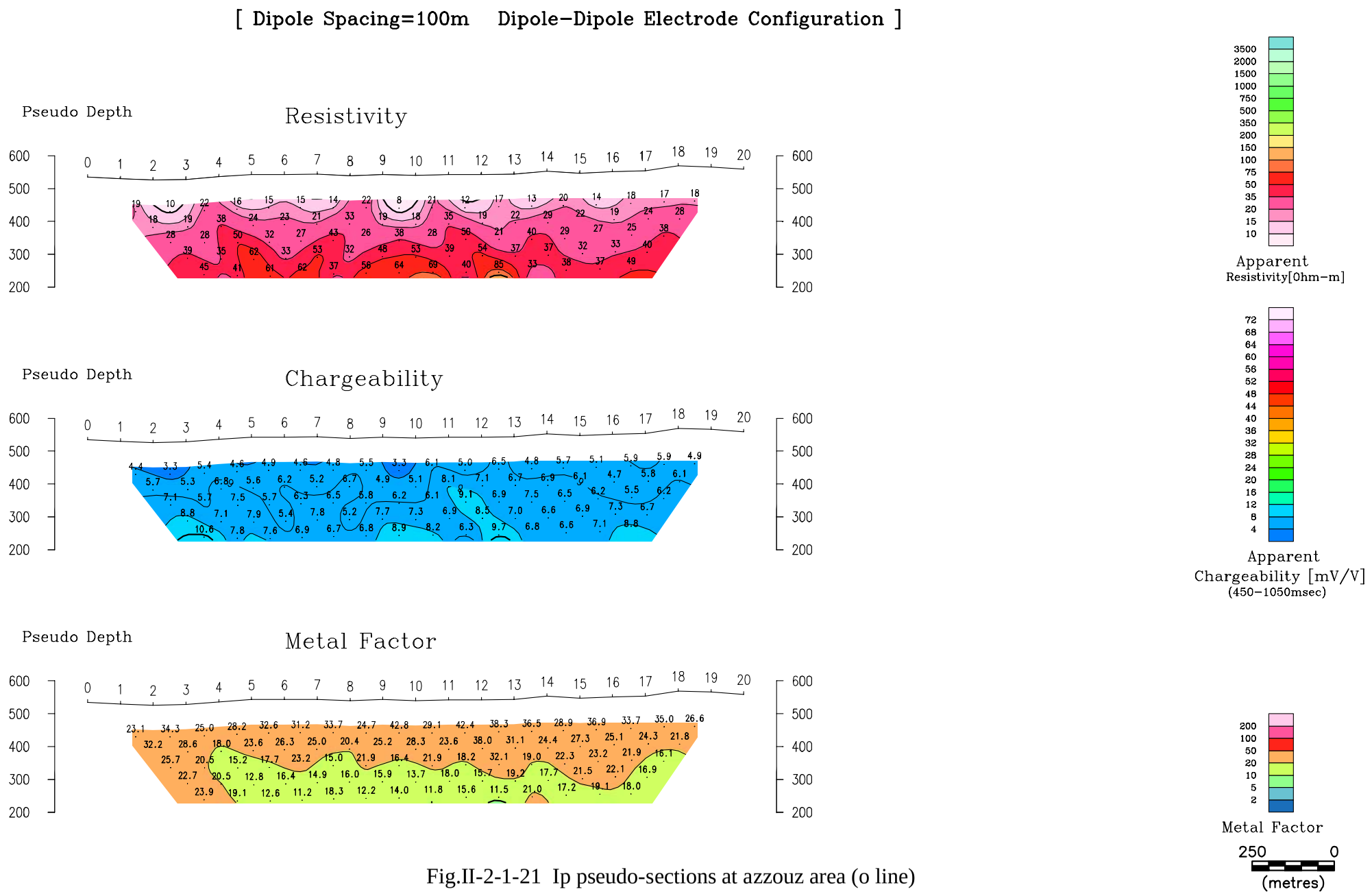


Fig.II-2-1-21 Ip pseudo-sections at azzouz area (o line)

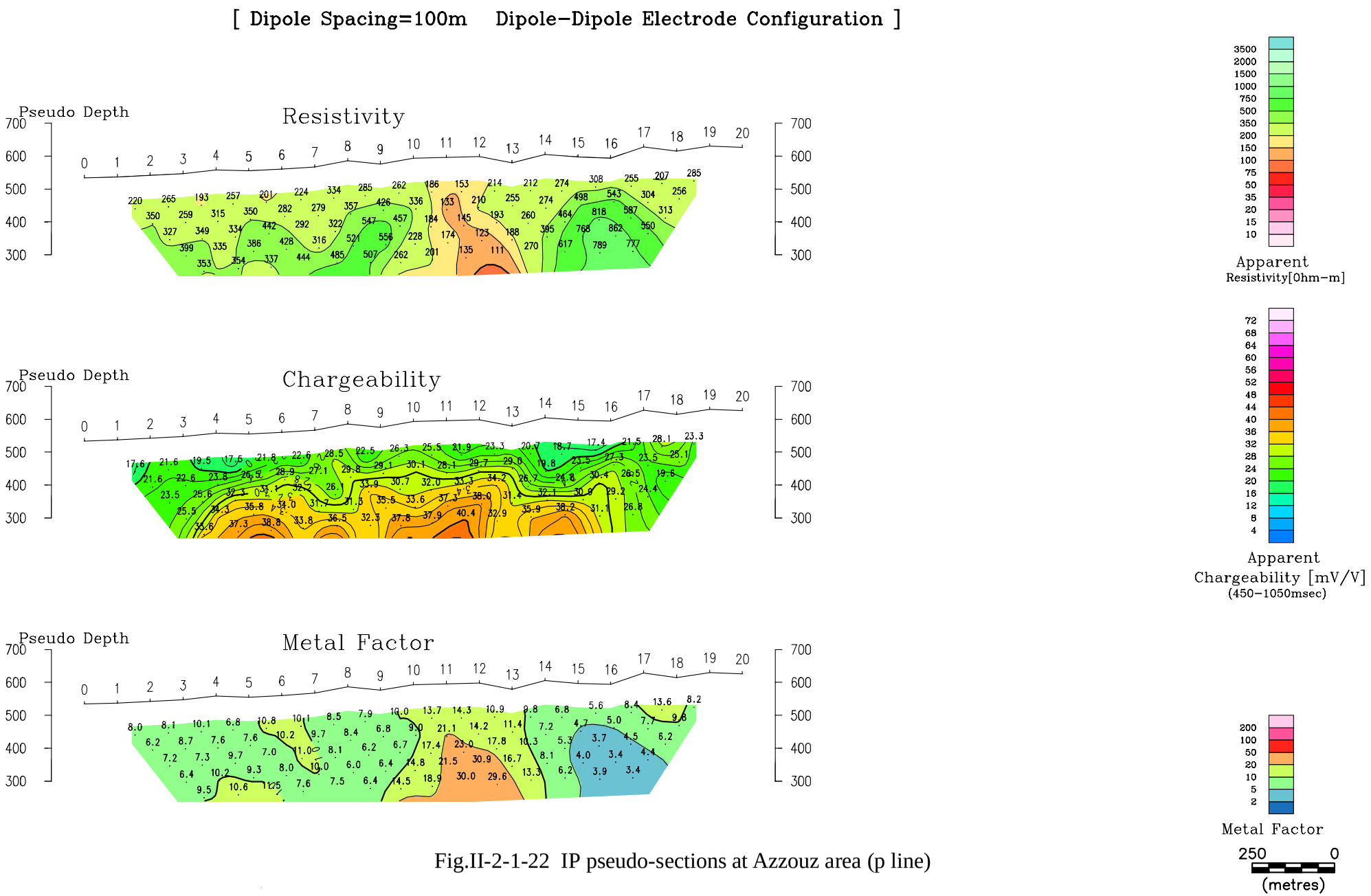


Fig.II-2-1-22 IP pseudo-sections at Azzouz area (p line)

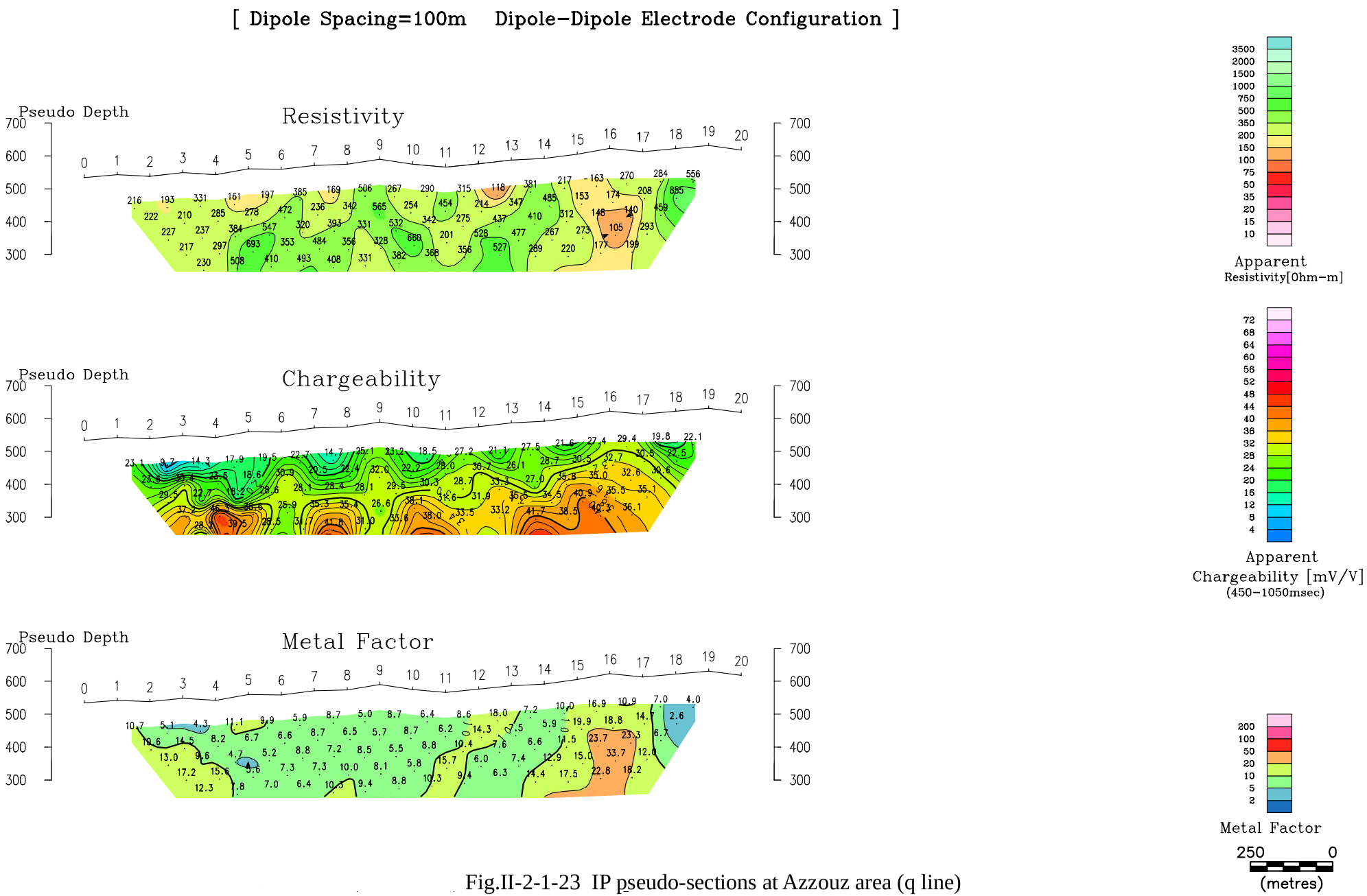


Fig.II-2-1-23 IP pseudo-sections at Azzouz area (q line)

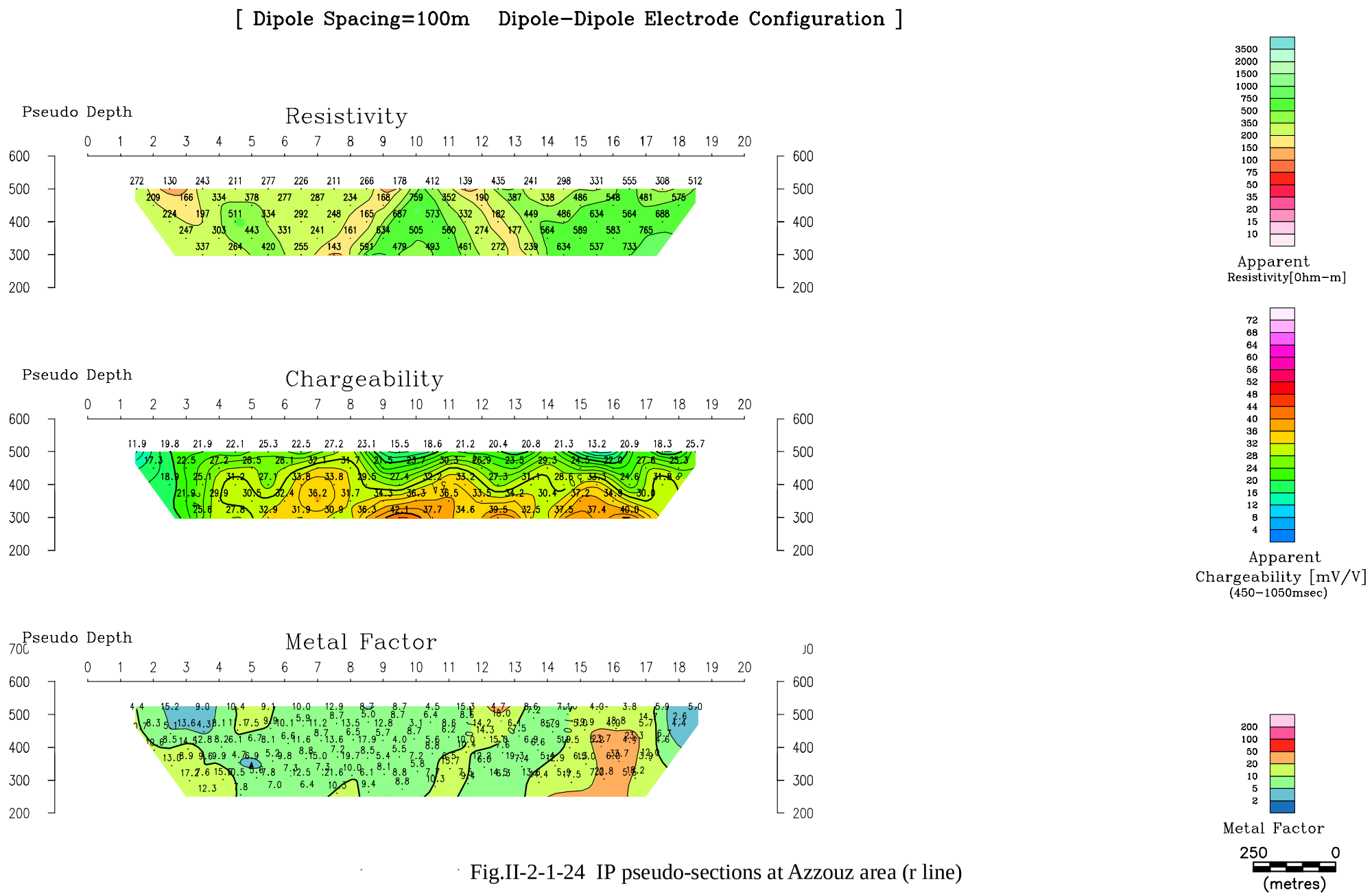


Fig.II-2-1-24 IP pseudo-sections at Azzouz area (r line)

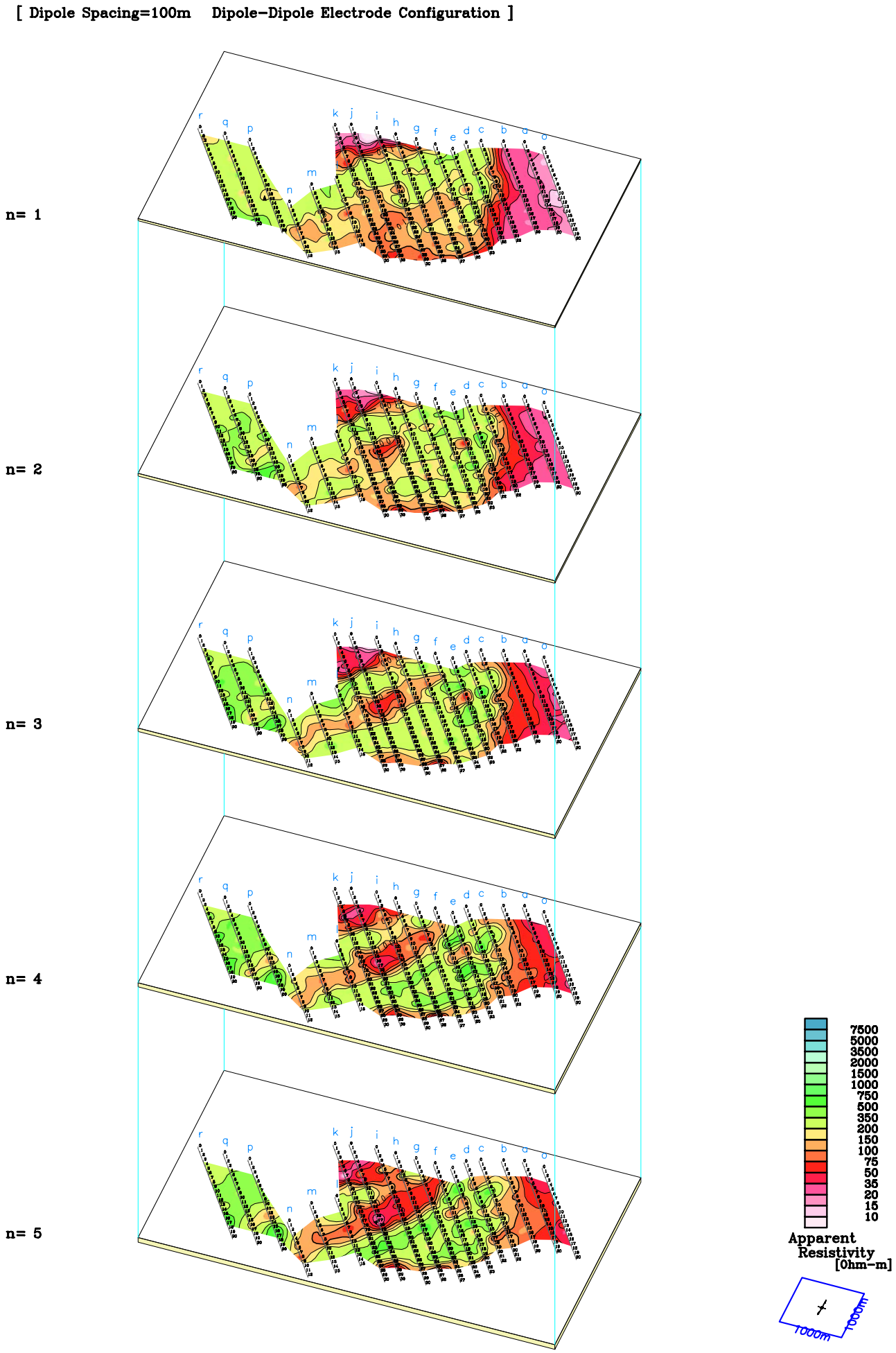


Fig.II-2-1-25 Plane map of apparent resistivity at Azzouz area

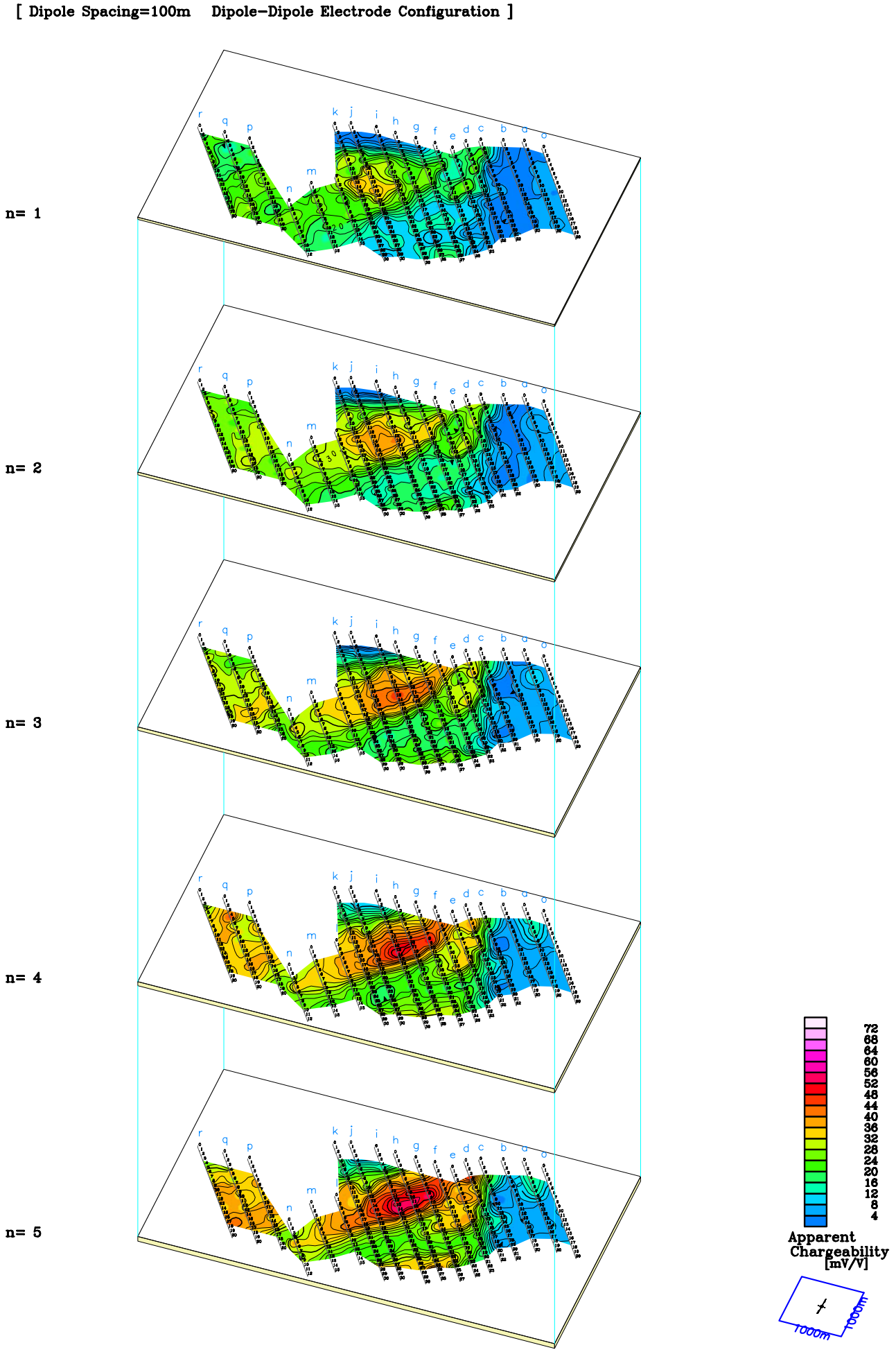


Fig.II-2-1-26 Plane map of apparent chargeability at Azzouz area

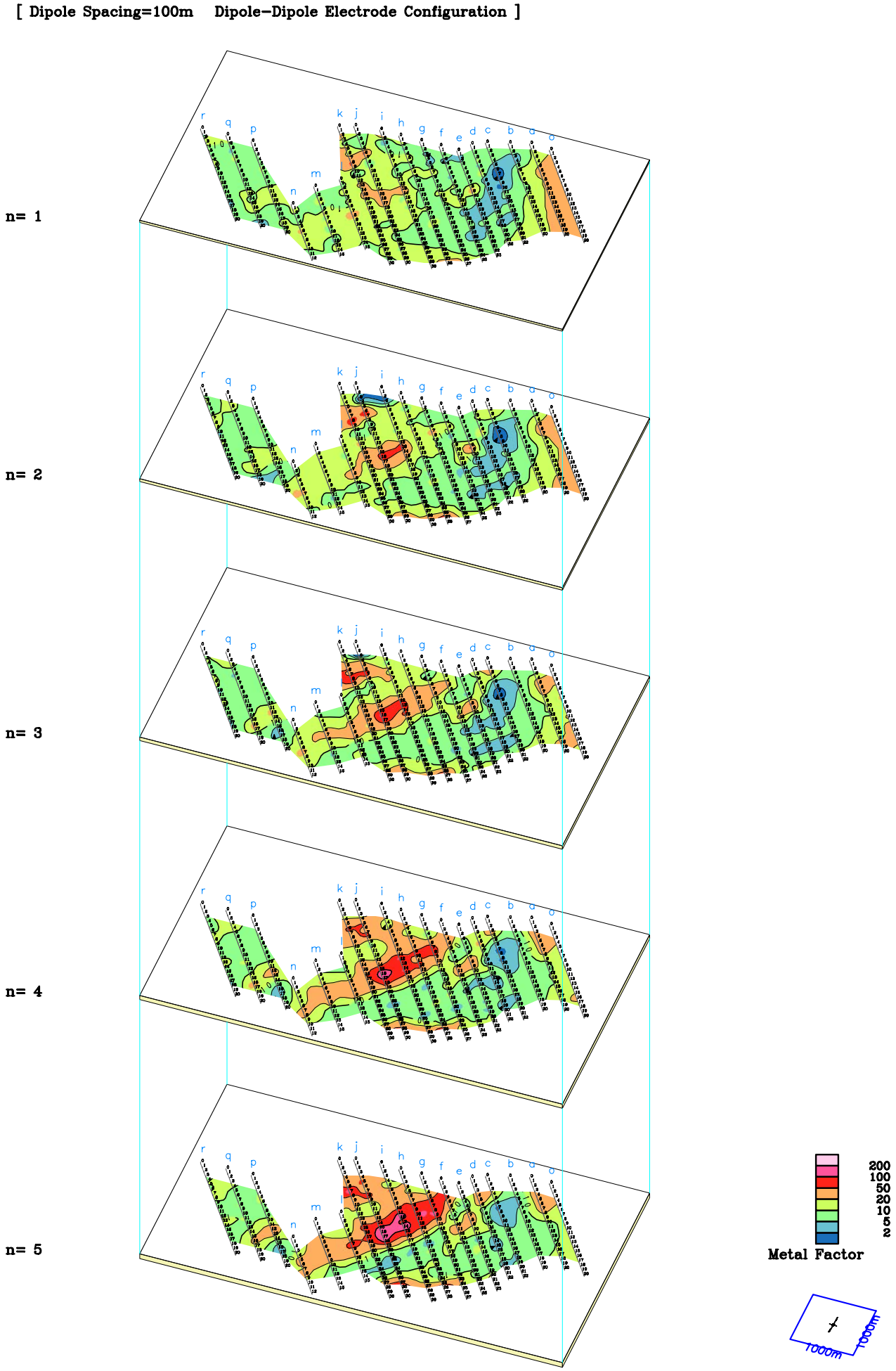


Fig.II-2-1-27 Plane map of metal factor at Azzouz area

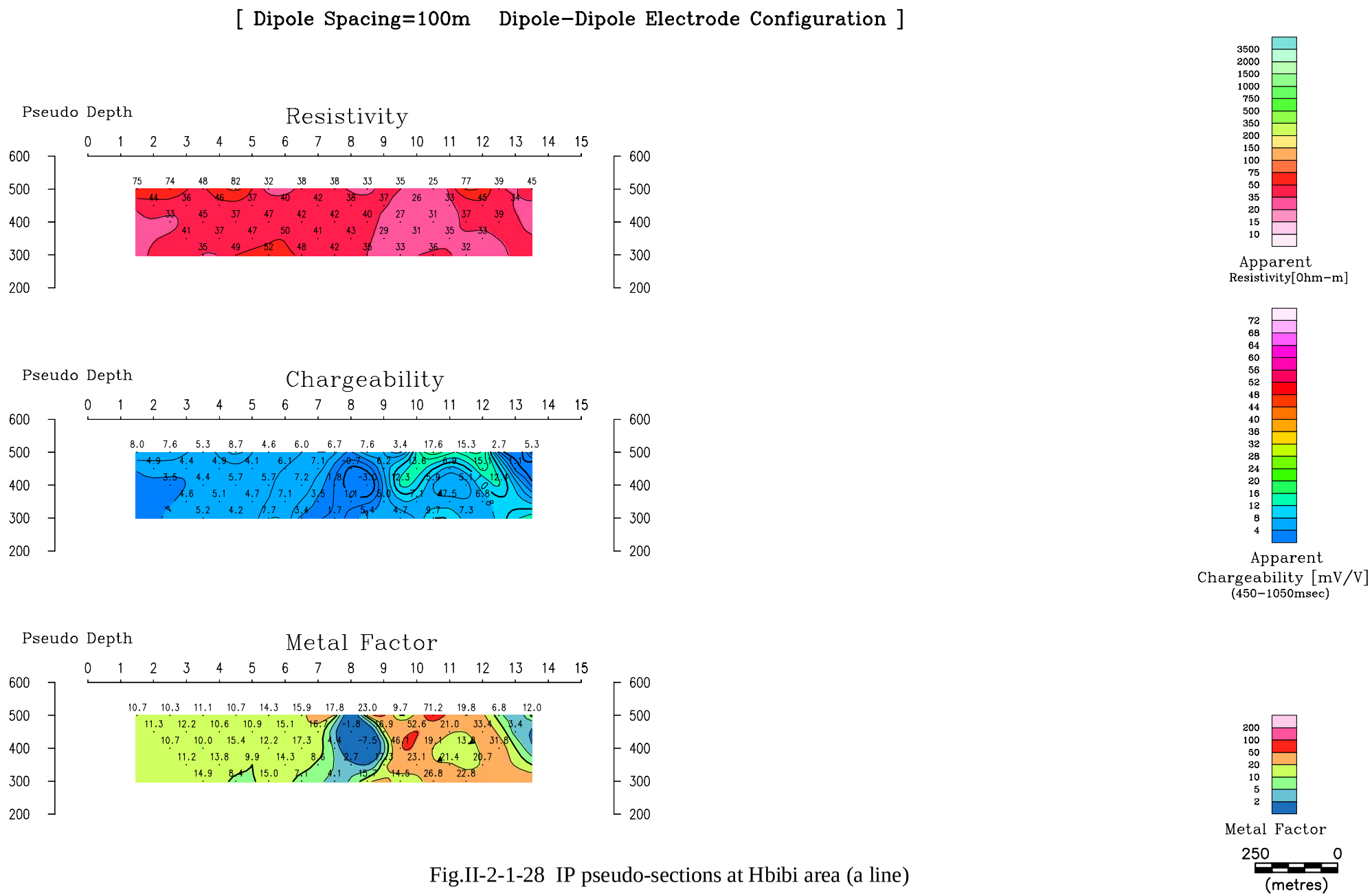


Fig.II-2-1-28 IP pseudo-sections at Hbibi area (a line)

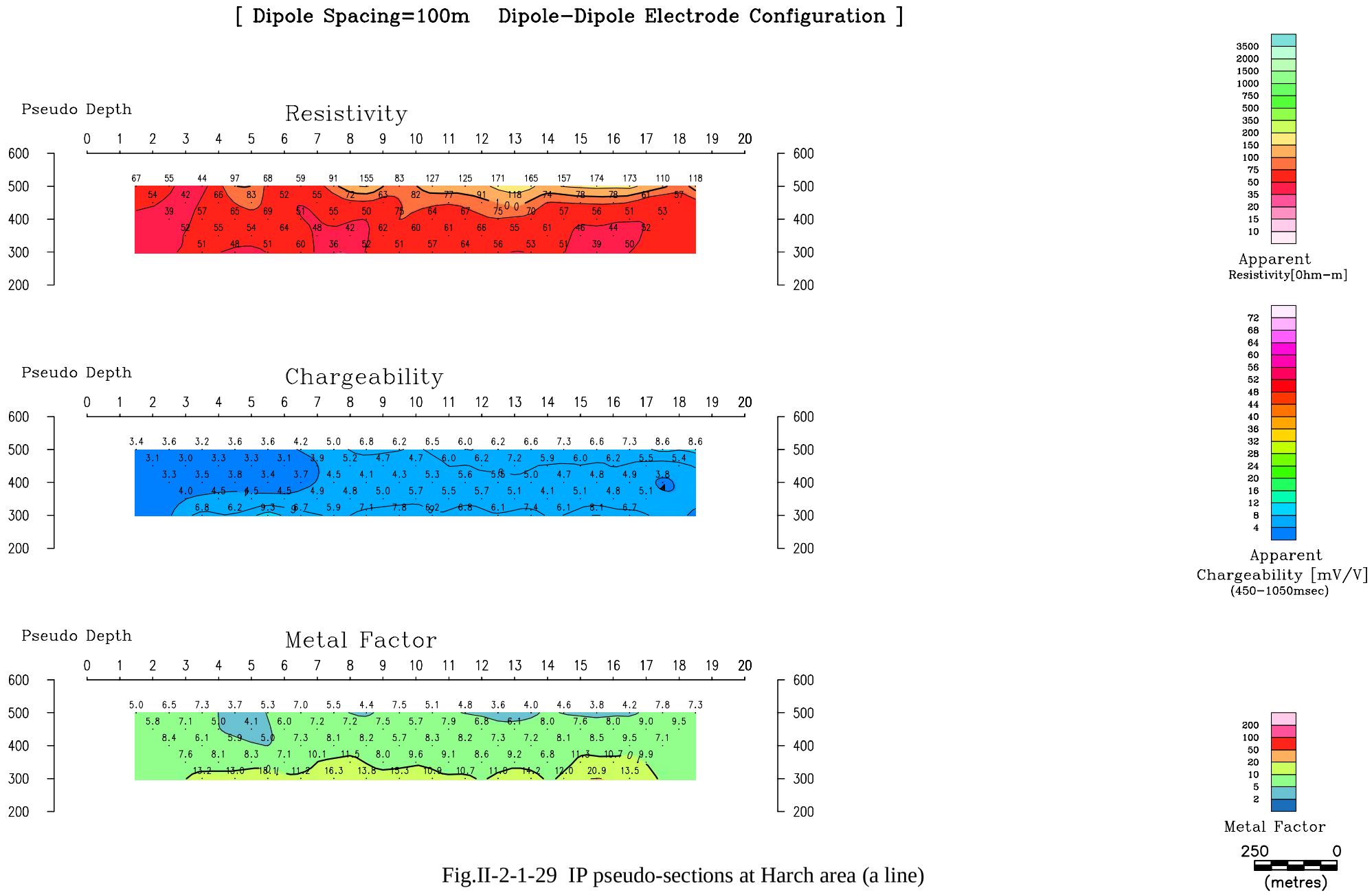


Fig.II-2-1-29 IP pseudo-sections at Harch area (a line)

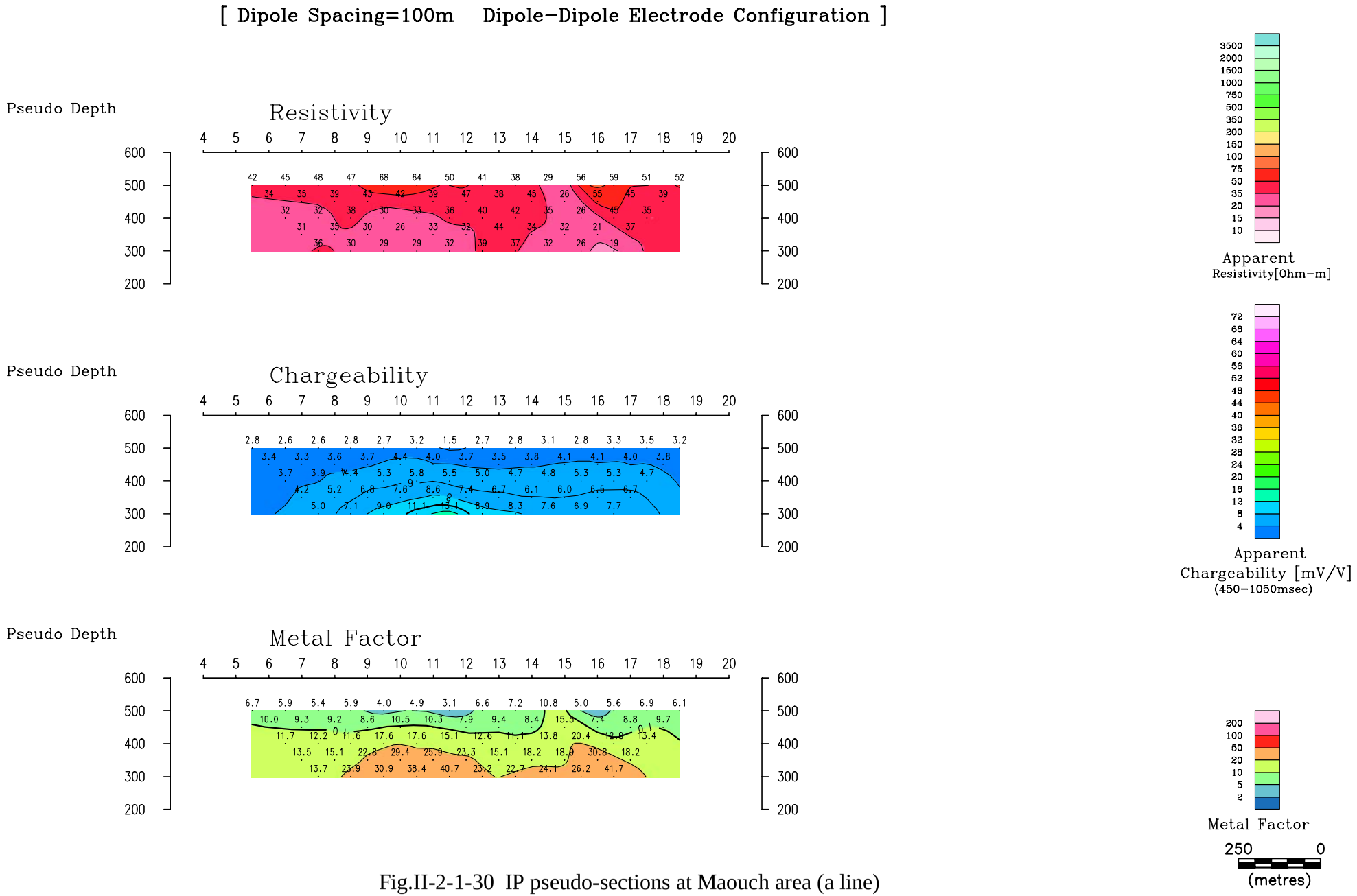


Fig.II-2-1-30 IP pseudo-sections at Maouch area (a line)

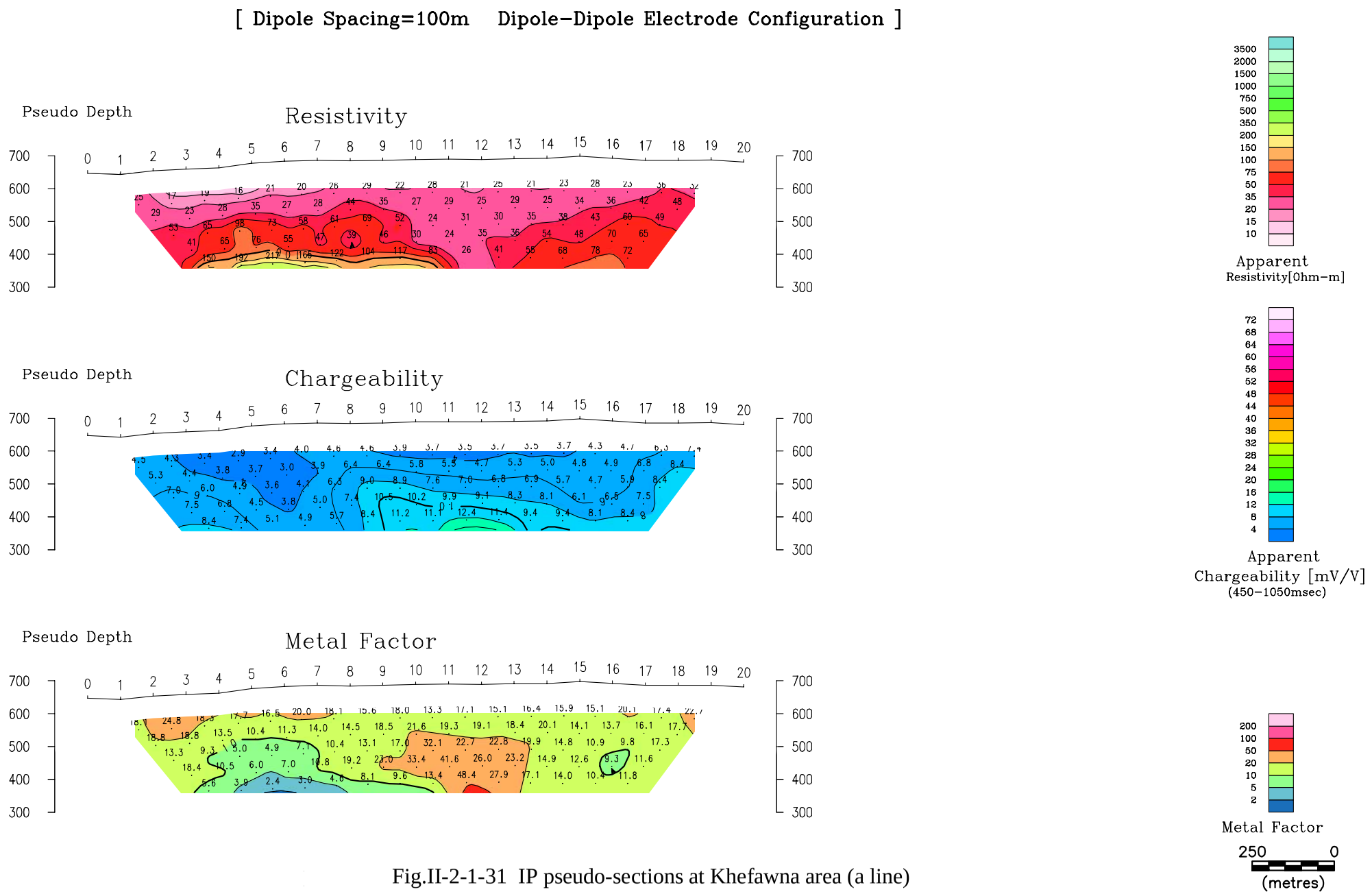


Fig.II-2-1-31 IP pseudo-sections at Khefawna area (a line)

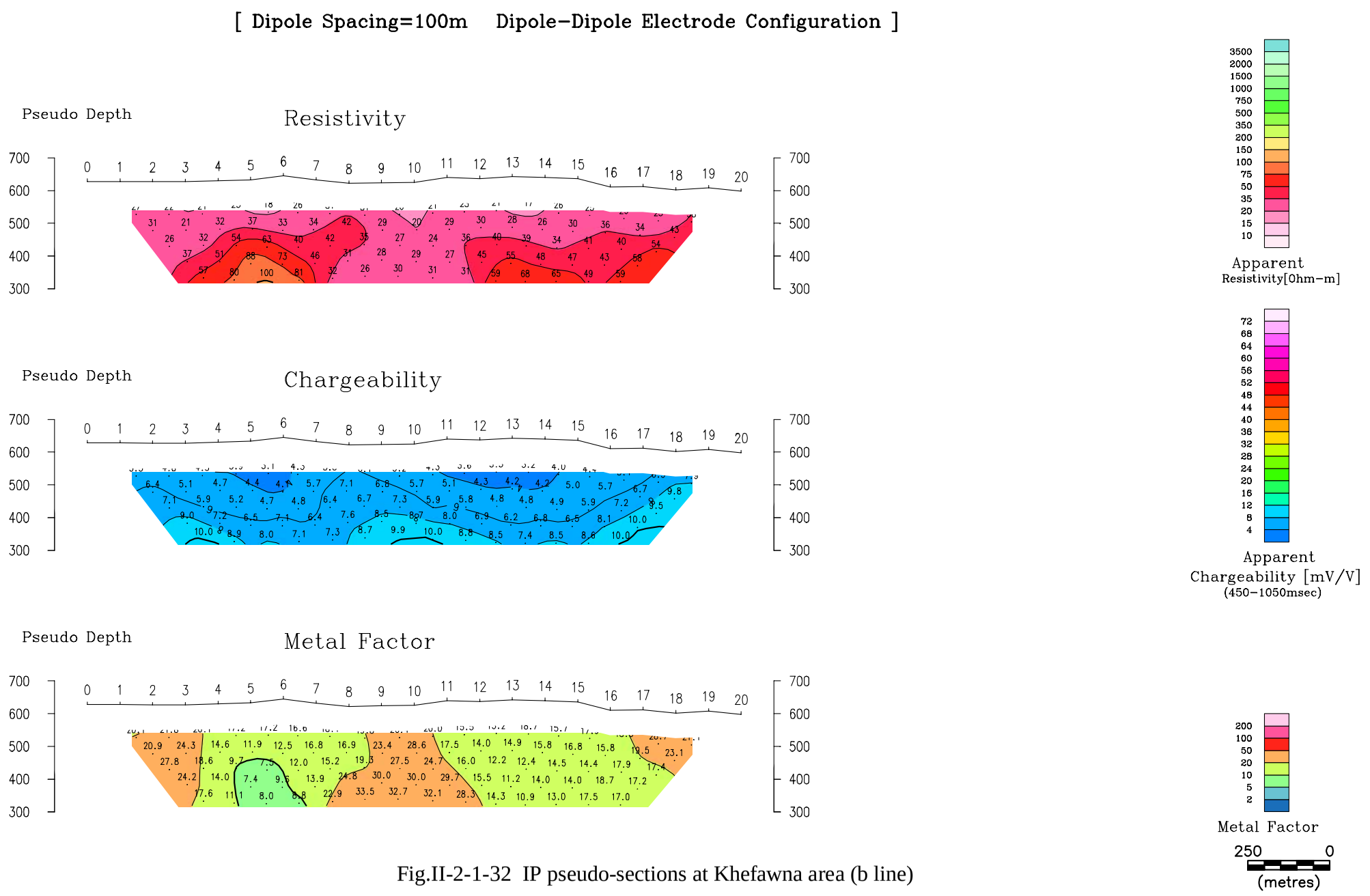


Fig.II-2-1-32 IP pseudo-sections at Khefawna area (b line)

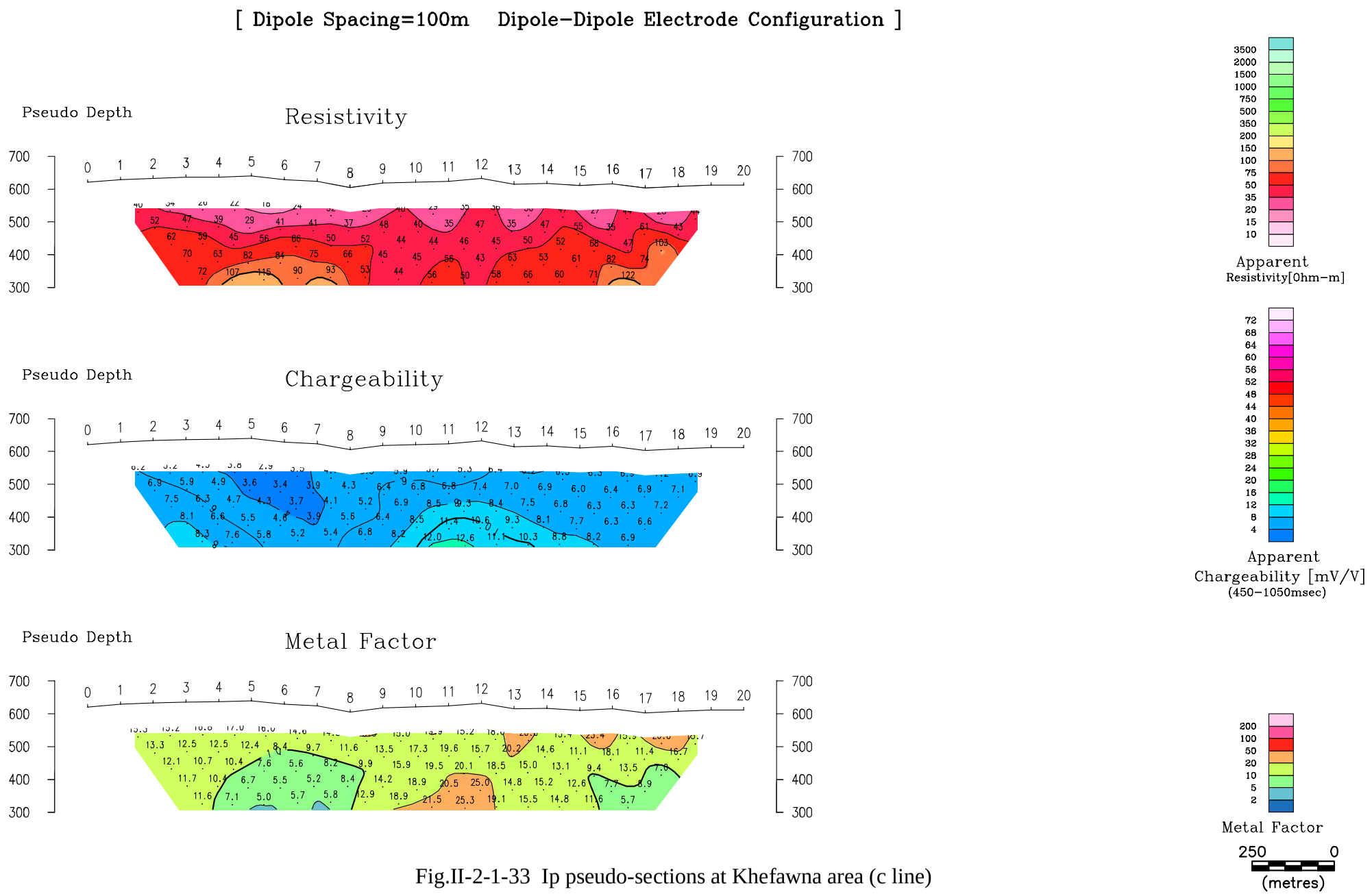


Fig.II-2-1-33 Ip pseudo-sections at Khefawna area (c line)